中古モジュール外観チェックシート

						JQAファイル 部材/検査項目																				
添付ID	メーカー	型番	Type	シリアルNo	定格值表示	シリアルのみ0 初期値と最終年:1	ガラス		封止材			セル			配線				バックシー	-ト		端子	вох	総合	作業者	外観試験日
7.7 A 1 3 - D			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		(有:1)	経時変化:2	the total	++ -+-		7.0.11	ebul I.	44.18	104	Nor 4 th	HD 11/1	7.0.11		Ada , 12		' 4 El	7.0.11		7.0.11	101	11 74 1	
CNS2010-133	Δ			予借191	1	H13年のみ:3	割れ その他	黄炎	日海/テフミ	その他	割れ	焦け	その他	断線	焦け	その他	変色	焦け	2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010	- 電殺	その他	固定具合	その他	判定	Δ.	2010 10 12
CNS2010-134	A	a4 a4	単結晶	読み取り不可	1	Ŭ	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	2010.10.12
CNS2010-135 CNS2010-136	A	a4	<u>単結晶</u> <u> <u> </u> <u> </u></u>	1222	1		0 0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	A	2010.10.12
CNS2010-130	c	c3		861171	1		0 0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	A	2010.10.12
CNS2010-138	E	e1	単結晶	454121			0 0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	С	2010.10.12
CNS2010-139	E	e1	<u>——早柏丽</u> ——単結晶	454124			0 0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	C	2010.10.12
CNS2010-141	С	c2	単結晶	なし	1		0 0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	В	2010.10.12
CNS2010-142 CNS2010-143	C F	c2 e2	<u>単結晶</u> 単結晶	なし A29278	1		0 0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	B	2010.10.12
CNS2010-144	B	b1	単結晶	87090237	1		0 0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	A	2010.10.12
CNS2010-145 CNS2010-146	B	b1 d1	<u>単結晶</u> 多結品	870906**	1	0	0 0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	A	2010.10.12
CNS2010-147	D	d1		91200107	1	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ā	2010.10.12
CNS2010-148	D	d1	<u>多結晶</u> 多結晶	91403029	1	1	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	2010.10.12
CNS2010-150	D	d1		91201186	1		0 0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	A	2010.10.12
CNS2010-151	D	d1	多結晶	91201087	1	1	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	2010.10.12
CNS2010-152	D	d1		91201232	1		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	2010.10.12
CNS2010-154	D	d1	多結晶	91201191	1		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	В	2010.10.12
CNS2010-155 CNS2010-156	D	dl d1	<u></u>	92X12062 92X12129	1	2	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	2010.10.12
CNS2010-157	D	d1	多結晶	92X12123	1	2	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Α	2010.10.12
CNS2010-158 CNS2010-159	D	d1 d1	<u> </u>	91201109 92X12050	1	3	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	2010.10.12
CNS2010-160	D	d1	多結晶	92X12108	1	3	0 0	0	0	Ő	Ő	0	0	Ő	0	0	0	0	0	0	0	0 0	Ő	Ő	B	2010.10.12
CNS2010-161	D	d1	<u>多結晶</u> 多結晶	91201189	1	3	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	2010.10.12
CNS2010-163	D	d1		92X12134	1	2	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	2010.10.12
CNS2010-164	D	d1	多結晶	92X12049	1	3	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	В	2010.10.12
CNS2010-165	D	d1	<u></u>	91403021	1	1	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	2010.10.12
CNS2010-167	D	d1	多結晶	91403011	1	1	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	В	2010.10.12
CNS2010-168 CNS2010-169	D	d1	<u></u> 多結晶	91201181	1	1	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	2010.10.12
CNS2010-170	D	d1	多結晶	91201067	1	1	0 0	0	0	0	0	0	Ő	0	0	0	0	0	Ő	0	0	0	0	Ő	C	2010.10.12
CNS2010-171 CNS2010-172	D	d1	<u>多結晶</u> 多結晶	91201068	1	1	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	2010.10.12
CNS2010-173	D	d1	多結晶	91201078	1	1	0 0	0	0	0	0	0	0	Ő	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	Ċ	2010.10.12
CNS2010-174	D	d1	<u>多結晶</u> 多結晶	91201135	1	4	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	2010.10.12
CNS2010-176	D	d1	多結晶	91201083	1	1	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	2010.10.12
CNS2010-177	D	d1	多結晶	91201089	1	1	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	2010.10.12
CNS2010-178 CNS2010-179	D	d1	<u></u>	91201069	1		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	2010.10.12
CNS2010-180	D	d1	多結晶	91201124	1		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С	2010.10.12
CNS2010-181 CNS2010-182	D	d1 d1	<u>多結晶</u> 多結晶	91201076	1		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	2010.10.12
CNS2010-209	A	a2	単結晶	891628	1		0 0	2	1 Î	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	B	2010.10.12
CNS2010-210 CNS2010-211	A	a2 a2	<u>単結晶</u> 単結晶	891614	1		0 0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	B	2010.10.12
CNS2010-212	A	a2	単結晶	891593	1		0 0	2	1	Ő	Ő	Ő	1	Ő	0	Ő	0	0	0	0	Ő	0 0	Ő	2	B	2010.10.12
CNS2010-213	A	a2	<u>単結晶</u> 単結晶	891594	1		0 0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	B	2010.10.12
CNS2010-215	Ā	a2 a2	単結晶	891590	1		0 0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	B	2010.10.12
CNS2010-216	A	a2	単結晶	891141	1		0 0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	B	2010.10.12
CNS2010-217	A	az a2	<u>単和間</u> 単結晶	891064	1		0 0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	B	2010.10.12
CNS2010-219	A	a2	単結晶	891137	1		0 0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	B	2010.10.12
CNS2010-220 CNS2010-221	A	al a1	<u>単結晶</u> 単結晶	100721	1		0 0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	В	2010.10.12
CNS2010-222	A	al	単結晶	100719	1		0 0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	B	2010.10.12
CNS2010-223 CNS2010-224	A	a1 a1	<u>単結晶</u> 単結晶	100720	1	╉────┤	0 0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	B	2010.10.12
CNS2010-225	A	al	単結晶	100610	1		0 0	0 0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ő	Ő	0	0	0	1	В	2010.10.12
CNS2010-226 CNS2010-227	A	a1	<u>単結晶</u> 単結晶	100607	1		0 0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	B	2010.10.12
CNS2010-228	A	a1	単結晶	100477	1		0 0	0	1	Ő	Ő	Ő	Ő	Ő	0	0	0	0	0 0	0	Ő	0 0	Ő	1	В	2010.10.12
CNS2010-229	A	a1	単結晶	100479	1		0 1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	A	2010.10.12
CNS2010-231	A	al al	<u>半和明</u> 単結晶	100475	1		0 0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	B	2010.10.12
CNS2010-232	A	a2	単結晶	891148	1		0 0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	A	2010.10.12
CNS2010-233	A	az a2	<u>甲和明</u> 単結晶	891123	1		0 0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	B	2010.10.12
CNS2010-235	A	a2	単結晶	891070	1		0 0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	В	2010.10.12
CNS2010-236 CNS2010-237	A	a2 a2	<u>単結晶</u> 単結晶	891618 891098	1		0 0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	B	2010.10.12
CNS2010-238	A	a2	単結晶	891596	1		0 0	2	1	Õ	0	Ö	0	Ő	Ő	1	Ő	0	Ő	Ő	0	Ő	Ő	2	Ā	2010.10.12
CNS2010-239 CNS2010-240	A A	a2 a2	 単結晶 単結晶 	891155	1		0 0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	B	2010.10.12
CNS2010-241	Â	a2	単結晶	891397	1		0 0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	A	2010.10.12
CNS2010-242	B	b1	単結晶	87090478	1		0 0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	B	2010.10.12
CNS2010-243	B	b1	単結晶	87090232	1		0 0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	B	<u>2010.10.12</u> 2010.10.12
CNS2010-245	В	b1	単結晶	87090470	1		0 0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	C	2010.10.12
CNS2010-246 CNS2010-247	B	b1 b1	<u>単結晶</u> 単結晶	8***0600	1		0 0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	A	2010.10.12
CNS2010-248	В	b1	単結晶	87090602	1		0 0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	С	2010.10.12
CNS2010-249 CNS2010-250	B	b1	<u>単結晶</u> 単結品	87090601	1	├ ───┼	0 0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	B	2010.10.12
CNS2010-251	В	b1	<u>一一一一</u> 単結晶	87090253	1		0 0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	c	2010.10.12

中古モジュール外観チェックシート

						JQAファイル	ル 部材/検査項目																				
添付ID	メーカー	型番	Туре	シリアルNo	定格值表示 (右·1)	シリアルのみ0 初期値と最終年:1	ガ	ラス		封止材			セル			配線				バックシー			端子	BOX	総合	作業者	外観試験日
					(10.17	経時変化:2 H13年のみ:3	割れ	その他	黄変	白濁/デラミ	その他	割れ	焦げ	その他	断線	焦げ	その他	変色	焦げ	変形	亀裂	その他	固定具合	その他	判定		
CNS2010-252	В	b1	単結晶	?8225?	1		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	С	2010.10.12
CNS2010-253	В	b1	単結晶	不明	1		0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	Α	2010.10.12
CNS2010-254	A	a2	単結晶	901061	1		0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	A	2010.10.12
CNS2010-255	A	a2	単結晶	901036	1		0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	A	2010.10.12
CNS2010-256 CNS2010-257	Α Δ	a2 a2	単和明	891231	1		0	0	<u> </u>	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	A A	2010.10.12
CNS2010-258	A	a2	単結晶	891507	1		0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	A	2010.10.12
CNS2010-259	A	a2	単結晶	891505	1		0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	A	2010.10.12
CNS2010-260	Α	a2	単結晶	891286	1		0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	A	2010.10.12
CNS2010-261	A	<u>a2</u>		891466	1		0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	B	2010.10.12
CNS2010-262	A	a2	単結晶	891508	1		0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	C	2010.10.12
CNS2010-264	Δ Α	a2 a2	単結晶	891354	1		0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	B	2010.10.12
CNS2010-265	A	a2	単結晶	891288	1		0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	B	2010.10.12
CNS2010-266	А	a2	単結晶	891287	1		0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	В	2010.10.12
CNS2010-267	A	a2	単結晶	891506	1		0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	C	2010.10.12
CNS2010-268	A	a2	単結晶	891285	1		0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	C	2010.10.12
CNS2010-269 CNS2010-270	Α Δ	a2 91	単和明	100573	1		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	C	2010.10.12
CNS2010-271	Ā	a1	単結晶	100464	1		0	0	0	1	0 0	0 0	Ő	Ő	0	0	0	0	0	0	ŏ	0	0	0	1	B	2010.10.12
CNS2010-272	A	a1	単結晶	100574	1		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	В	2010.10.12
CNS2010-273	A	a1	単結晶	100778	1		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	С	2010.10.12
CNS2010-274	A	a1	単結晶	100572	1		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	В	2010.10.12
CNS2010-275	A	al	単結晶	100598	1		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	В	2010.10.12
CNS2010-270	Δ Α	a1	単結晶	100371	1		0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	B	2010.10.12
CNS2010-278	A	a1	単結晶	100466	1		0	0	0	1	Ŭ	Ő	Ő	Ő	0	0	0	Ő	0	Ő	Ő	Ő	Ő	0	1	B	2010.10.12
CNS2010-279	А	a1	単結晶	100775	1		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	В	2010.10.12
CNS2010-280	A	a1	単結晶	100465	1		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	В	2010.10.12
CNS2010-281	A	a1	単結晶	100597	1		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	B	2010.10.12
CNS2010-282 CNS2010-283	Α Δ	a2 22	単和明	891413	1		0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	C	2010.10.12
CNS2010-284	Ā	a2 a2	単結晶	891571	1		0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	c	2010.10.12
CNS2010-285	A	a2	単結晶	891569	1		0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	C	2010.10.12
CNS2010-286	Α	a2	単結晶	891548	1		0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	С	2010.10.12
CNS2010-287	A	a2	単結晶	891572	1		0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	В	2010.10.12
CNS2010-288	A	a2	単結晶 単結目	891558	1		0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	C	2010.10.12
CNS2010-289	Δ Α	a2 a2	単結晶	891536	1		0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	C	2010.10.12
CNS2010-291	A	a2	単結晶	891429	1		0	0	2	1	Ő	Ő	Ő	1	0	0	0	Ő	0	Ő	Ő	0	Ő	0	2	B	2010.10.12
CNS2010-292	Α	a2	単結晶	891570	1		0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	В	2010.10.12
CNS2010-293	A	a2	単結晶	891524	1		0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	В	2010.10.12
CNS2010-447	F	f1	a-Si溥膜	111005		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	2010.10.12
CNS2010-448	F	f1	a-Si薄膜	111001	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	2010.10.12
CNS2010-450	A	a3	単結晶	920001	1	1	ŏ	0	1	1 1	0	0	ŏ	0	0	0	0	0	0	ŏ	0	0	0	0	1	Ă	2010.10.12
CNS2010-451	A	a3	単結晶	920002	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Α	2010.10.12
CNS2010-452	A	a3	単結晶	920003	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	A	2010.10.12
CNS2010-453	A	<u>a3</u>		910210	1		0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	A	2010.10.12
CNS2010-454	A	a3 £1		920004		2	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	2010.10.12
CNS2010-474	F	f1	a-Si薄膜	111146		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C C	2010.10.12
CNS2010-476	F	f1	a−Si薄膜	111137		2	0 0	Ũ	Ő	Ő	Ő	0	Ő	0	Ő	0	Ő	Ő	Ő	Ő	0	0	Ũ	0 0	0	Č	2010.10.12
CNS2010-478	D	d1	多結晶	91403148	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	В	2010.10.12
CNS2010-479	D	d1	多結晶	91201146	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	В	2010.10.12
CNS2010-480	D P	<u>d1</u>	<u>多結晶</u> 当 出 出 日	92X12023	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	В	2010.10.12
CNS2010-481	C D	C1	<u> 単 和 明</u> 単 結 晶	910211 予備913216		2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A C	2010.10.12
CNS2010-483	č	c1	単結晶	3-913149	1	2	0	0	0	Ő	Ő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	В	2010.10.12
CNS2010-484	Α	a3	単結晶	920011	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Α	2010.10.12
CNS2010-485	A	a3	単結晶	920018	1	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	A	2010.10.12
CNS2010-486	A	a3	単結晶	920023		2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	A	2010.10.12
CNS2010-487	A	a3	単桁面 単純旦	920083	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	A	2010.10.12
CNS2010-489	Ā	a3	単結晶	920095	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Ā	2010 10 12



CNS2010-141 外観抽出品 <順熱画像>



CNS2010-141 外観抽出品 <外観>



CNS2010-141 外観抽出品 <EL、MAP>



白濁部下側のセルは、クラックが多数入っている。 EL,MAPで暗くなっている部分のバックシートにはがれが見える MAP像でシャント気味のセルが確認できる



EL像

コメント: ELの影の部分とMAPの影の部分がほぼ一致。 MAPでシャント部を複数確認。(出力には大きな影響ないものと思われる)

MAP像







CNS2010-146 外観抽出品 <順熱画像>



表面(ガラス面)

裏面(バックシート面)

コメント:

CNS2010-146 外観抽出品 <外観>



外観OK,裏にはセル間などにスジが見られるが、 同じメーカの製品は初生品含めて全て同様で、作成時からあったと推測される。

CNS2010-146 外観抽出品 <EL、MAP>



コメント:

ELとMAPで明暗部が明確に相関するセルが多く確認されたが、MAPのみ確認される明部も確認された(シャント)。 熱画像発熱部がEL明部に対応している。



CNS2010-151 外観抽出品 <外観>



CNS2010-151 外観抽出品 <順熱画像>



CNS2010-151 外観抽出品 <EL、MAP>



コメント:ストリングの2本のバスバーのうちー方のバスバーに沿って暗部が集中。 サーモの低温部に対応。 ELとMAPで異なる部分が有る。



CNS2010-162 経時特性抽出品(Pmax,FF低下) <外観>



写真ファイル RIMG0201.JPG

無し **拡大写真**

CNS2010-162 経時特性抽出品(Pmax,FF低下) <順熱画像>



CNS2010-162 経時特性抽出品(Pmax,FF低下) <EL、MAP>





EL像

MAP像

コメント:

セル上の片方のバスライン側にMAP像暗部が集中。EL像暗部とも比較的よく対応。 程度はセルによりバラバラ。同型式予備品(167,480)ELでも一部セルに兆候? →明暗それぞれのサイドのタブ線の接続状況が異なる? 暗部は熱画像で低温









外観OK, 裏にはセル間などにスジが見られ るが、D社品は初生品含めて全て同様で、 作成時からあったと推測される。



10/11/12

裏面(バックシート面)

CNS2010-163 <EL, MAP>



コメント:

ELとMAPは明暗部が良く対応しているが、MAPのみに見える明部が一部確認された。 ELにおいて、右から1列目セルは左側が、2列目セルは右側が明部が縦に連続している傾向が確認。



外観(表面) 拡大写真 コメント: ・判定0(屋外で実暴露されていたようには見えない美品) ・写真ファイル RIMG0170.JPG





CNS2010-216 外観抽出品 <順熱画像>



CNS2010-216 外観抽出品 <外観>



CNS2010-216 外観抽出品 <EL、MAP>



コメント:白濁・デラミ箇所に大きな欠陥等は見られなかった。 EL, MAPでほぼ同様なパターン



CNS2010-227 外観抽出品 <順熱画像>



CNS2010-227 外観抽出品 <EL, MAP>



CNS2010-239 外観抽出品 <I-Vカーブ>

포치					
	Pmax(W)	Voc(V)	Isc(A)	Vpm(V)	Ipm(A)
定格	47.2	-	-	15.9	2.97
測定値	40.7	19.5	3.1	15.0	2.71



初期値(ラベル値)

りとなっているが、見つからず。



CNS2010-239 外観抽出品 <順熱画像>









・ところどころ暗い部分があるが、外観変化(黄変)との明確な相関は無い。

MAP:シャントぎみのセル多数。白濁、黄変の出力低下なし。右端に水垢(?)による出力低下あり。



CNS2010-241 外観抽出品 <外観>



CNS2010-241 外観抽出品 <順熱画像>



CNS2010-241 外観抽出品 <EL、MAP>



コメント:

EL像:IVカーブに異常が見られる同型のA社品モジュールと比較して、 特に大きな差は見られない。ただし、無数の小さな異常(シミ)は見られる。 また、無数のクラックのような傷が見られる。 ELとMAPは1箇所を除いて一致している

CNS2010-242 外観抽出品 <I-Vカーブ>

コメント: IVカーブ異常。CNS-145と同じ症状? セル別のI-V測定してはどうか Pmax Voc Isc FF Eff 定格 42.0 18 3.26 --初期値 -32.48 3.01 17.76 9.15 測定値 17.76 電流 A 電力 W 5.00 50.0

なし 「中古モジュールチェックシート」 では平成13年のみありとなって いるが、見つからず。

初期値



CNS2010-242 外観抽出品 <順熱画像>



CNS2010-242 外観抽出品 <EL、MAP>



コメント:EL像の影が多数みられる。欠陥外観異常との位置相関なし。 MAP像の影と白濁の位置が一致. 白濁部では40%程度の出力低下が見られる.

CNS2010-242 外観抽出品 <外観>





CNS2010-243 外観抽出品 <順熱画像>



CNS2010-243 外観抽出品 <外観>



CNS2010-243 外観抽出品 <EL、MAP>



コメント: ELの影の部分とMAPの影の部分がほぼ一致。 MAPで白濁部の影を確認。(ELの影とも重複するが、MAPで差が出る) MAPでシャント部を複数確認。(出力には大きな影響ないものと思われる)



CNS2010-244 外観抽出品 <外観>



CNS2010-244 外観抽出品 <順熱画像>



CNS2010-244 外観抽出品 <EL、MAP>



コメント: コゲの真裏のセルコーナー白濁部がEL,MAPとも影がある。 EL,MAPの傾向はほぼ同じ

CNS2010-245 外観抽出品(デラミ)<I-Vカーブ>

Type:単結晶

なし

初期値

	Pmax(W)	Voc(V)	Isc(A)	FF(%)	測定年
定格	42.0	14.5	2.9		
初期値					
測定値	34.4	17.7	2.95	65.77	2010



コメント:定格と比較して、Pmaxの劣化が激しく、

IVカーブから不良が確認される。

CNS2010-245 外観抽出品(デラミ) < 順熱画像>



CNS2010-245 外観抽出品(デラミ) <外観>





拡大図

(画像向き修正済み)

外観(表面) 拡大写真 コメント: 変形度合いは「封止村:黄変1,白濁/デラミ3,バックシート:変形1,総合判定:3」 デラミは、セルの周辺ではなく、バスバー部分から起きている。 また、大型(セルの中央の大多数)と小型(配線付近)しかみられず、中型のものがない。 左右のバスバー電極付近がデラミすると、一気に大型になる?

CNS2010-245 外観抽出品(デラミ) < EL、MAP>



EL像では見られない明部が見られる(中央付近、右上)(シャント短絡?)

CNS2010-246 外観抽出品(245比較,BS変形) <I-Vカーブ>



CNS2010-246 外観抽出品(245比較,BS変形)



CNS2010-246 外観抽出品(245比較,BS変形) <順熱画像>



表面に顕著な異常なし。裏面バックシート膨れ部に低温スポット?

CNS2010-246 外観抽出品(245比較,BS変形) <EL、MAP>



EL画像でセル中ほどを中心に大きな雲状の暗部多数。MAP画像の暗部とも相関あり。 MAP画像で明るいセル(シャント短絡?)はEL画像では異常はあまり見られない。



	Pmax	Voc	Isc	FF	測定年
定格	42.0	18.26	3.33		
初期値	-	-	-	-	
測定値	35.62	17.838	2.828	70.62%	2010年

なし

初期値

(ほぼすべての膨れで共通)



CNS2010-253 外観抽出品 <順熱画像>



CNS2010-253 外観抽出品 <外観>



CNS2010-253 外観抽出品 <EL、MAP>



コメント: 白濁部→ELでは異常なし。MAPで出力低下あり。 MAPでシャントやや低下セル複数あり(出力には大きな影響ないものと思われる)











裏面は異常なし。

コメント:







コメント:外観異常なし

CNS2010-449 経時抽出品 <順熱画像>



CNS2010-449 経時抽出品 <EL、MAP>



MAP像

コメント: EL像:発光していないセルが散見.スクライブの線に沿った影も多い中央部の影はサーモの影と位置が異なる。 MAP像:EL像とMAP像で相関あり。ただし、EL像では黒色になっているのに対し、 シャントの劣化よる白色部分が多数見られる。また、この部分は476(初生品)と比較して、明らかに多い。 また、発電部位はCNS475と比較して多いが、Iscは低い。シャント部分で溜まっている?または配線の影響?



拡大写真

外観(表面)

・小規模なデラミ(マイグレーション)発生

・裏面バックシートは綺麗.熱電対2箇所有り

←熱電対





2998 0°0

ы. Ю

34.6

: 泡中

裏面(バックシート面)

・暗輝度部の熱電対はモジュール内部の温度を測定している? →他の熱電対モジュールで確認?



CNS2010-451 経時抽出品 <順熱画像>



CNS2010-451 経時抽出品 <EL、MAP>



CNS2010-475 外観抽出品 <I-Vカーブ>



0.30

0.00 .0

5.0

10.0

拡大写真なし

電圧 V

測定値

15.0 20.0 25.0

CNS2010-475 外観抽出品 <順熱画像>



CNS2010-475 外観抽出品 <外観>



Ø

5

10

15

VOLTAGE (V)

初期値

20 25

外観上、同タイプのものと比較しても、特に大きな変化はなし。

CNS2010-475 外観抽出品 <EL、MAP>



EL像とMAP像で相関あり。なお、MAP像では、シャントの劣化による白色部分が多数見られる。(18箇所) 476,449と比較して、発電しているセルは少ない。

CNS2010-476 外観抽出品 <I-Vカーブ>





CNS2010-476 外観抽出品 <順熱画像>



CNS2010-476 外観抽出品 <外観>



拡大写真なし

外観(表面)

外観上、同タイプのものと比較しても、特に大きな変化はなし。

CNS2010-476 外観抽出品 <EL、MAP>



EL像とMAP像で相関あり。ただし、EL像では黒色になっているのに対し、 MAP像では、よる白色部分が多数見られる。(17箇所) シャントの劣化(もしくは、初期からすでにダメージを受けている)可能性あり。 また、シャント部分は、横のセルと相関があるようにも見受けられるが不明。



型式					
	Pmax	Voc	Isc	FF	Eff
定格	51.00	21.48(Vpm)	3.04(Ipm)	-	-
初期値	-	-	-	-	-
測定値	47.93	21.23	3.11	72.47	10.9

初期値

外観異常なし

・同型式で最もI-V特性の劣化が進んでいない(予備)
 ・CNS2010-163と対応
 94



CNS2010-480 経時データ抽出 <順熱画像>



CNS2010-480 経時データ抽出 <外観>



CNS2010-480 経時データ抽出 <EL、MAP>



外周部のセルがどちらかと言うとシャント気味に見えるが、全般的には良好。



CNS2010-482 経時データ抽出品 <順熱画像>



CNS2010-482 経時データ抽出品 <外観>



外観(表面)

拡大写真なし

CNS2010-482 経時データ抽出品 <EL、MAP>



セル起因?

MAP像

異常なし

MAPでシャント気味のセルが確認できる。



CNS2010-483 経時データ抽出品 <順熱画像>



CNS2010-483 経時データ抽出品 <外観>



拡大写真なし

外観(表面)

異常なし

CNS2010-483 経時データ抽出品 <EL、MAP>



セル起因? 左上のセルは肉眼では、クラック、白濁等は見えない IVIAL



CNS2010-485 経時抽出品 <順熱画像>



CNS2010-485 経時抽出品 <EL、MAP>



CNS2010-485 経時抽出品 <外観>





CNS2010-488 経時抽出品 <外観>



CNS2010-488 経時抽出品 <順熱画像>



CNS2010-488 経時抽出品 <EL、MAP>



・右下2セルのRsh低下

レーザーテック株式会社 先端開発室 平川 琢己

太陽電池効率分布測定機開発の背景

太陽電池モジュールは、25年を越える長期信頼性を 担保しながら、コストの引き下げを要求されている。 そのために、長期の使用でモジュールの内部で何が起 きているかを把握することが重要であり、特に直接電 気的特性に影響を及ぼす、電流密度分布を把握するこ とは、モジュールの状態を把握するための基本事項と 考えた。

従来、レーザービームを照射して光電変換特性を測 定する方法"LBIC (Laser Beam Induced Current)" はあったが、レーザーという特殊な光源のため太陽光 からの変換効率分布とはかけ離れた測定になってし まう。そこで太陽光をシミュレートする光源として一 般的なクセノンランプと大気での吸収特性を補正す るエアマスフィルター、バンドルファイバーを組み合 わせて、太陽光スペクトルに近いライン光源を構成し、備えている。 シリンドリカル光学系で太陽電池に投影する光学系 を選定した。このライン照明を太陽電池に当てて出て くる電流値は照明に沿って線積分された値であり、そ のままでは二次元の情報を持たないが、CT(コンピ ューテッド・トモグラフィー)の技術を応用したソフ トウェアにより、測定データの二次元化を行った。そ れは、点光源のスキャンでは、セルレベルで一枚数時 間という測定時間を要し、モジュールレベルではとて も実用化出来ないからである。ライン照明スキャンと CTソフトウェアの組み合わせで電流密度分布の正 確、かつ迅速な測定結果をもたらし、太陽電池変換効 率分布測定機MAPシリーズの製品化につながった。

変換効率分布を測定するための技術

標準の太陽光強度(100mW/cm²)下で太陽電 池セルの変換効率ηは

 $\eta = \operatorname{Jsc} * \operatorname{Voc} * FF$

の式で定義される。つまり効率分布を測定するために は短絡電流密度 Jsc、開放電圧 Voc 及びフィルファク ターFF を分布データの形で求められなければならな い。言い換えれば太陽電池セル各部分の I-V カーブを 全て求めなければならないことになる。MAP シリーズ では負荷電圧を変えながら、暗電流と光を当てたとき の光電流、両方を計測しながら測定する全ての画素

(測定の単位面積)に渡ってフィッティングを行って いる。光源として光学系の特性を含めてエアマスフィ ルターを設計することでスペクトルミスマッチを抑 え"Class A"精度、照明幅は 0.25mm、最大で太陽光 強度の10倍に達する高強度ライン照明を装備して いる。測定の絶対値を確保するためにキャリブレート されたセンサーを使い照明強度が正確に1SUN (1 00mW/cm²)となるように自動調整する機能も 備えている。



図-1に MAP システムのブロック図を示す。測定する ための可動部は照明の移動とサンプル台のθ回転の みとシンプルな構造となっている。

変換効率分布の数値化

光源のスキャン中に太陽電池で発生した光電流は高 精度のIV変換回路(電流・電圧変換回路)を通して デジタル化され、コンピューター上に記録される。こ れをプロットしたものを図-2に示すが、これは「サ イノグラム」と呼ばれる。サイノグラムをCTソフト ウェアで二次元データに変換したものを図-3に示 す。



図-2 測定電流値をプロットした「サイノグラム」



図-3 CTソフトで二次元化した電流密度マッピ ング

図-3に示すように、セル内の明暗は、疑似太陽光を 当てた時の取り出せた電流密度のマッピングを示し ている。この結果はEL法で取得したデータと一致し ている。また波線で囲まれたセルは、セルを二分割す る様に、効率にばらつきが出ており、インターコネク タの接続不良等の不具合が考えられる。

次に MAP シリーズの大きな特徴である、電流密度分 布の数値比較を示す。

/電流密度を測定したい部分(ライン)



図-4 白濁のあるモジュール



スライス・ライン

▲電流密度(mA/cm²)

図-5 白濁による電流密度の低下

図-4のように白濁のあるモジュールの電流密度 の違いを実測するには、図-5に示す MAP 画像のライ ス機能で、測定したい部分をスライス・ラインで指定 して、スライス・ライン上の電流密度(mA/cm²)を表示 させ、その出力の CSV ファイルより算出する。 このようにマッピング画像からは確認できない微小 な電流密度の変化もスライス機能を使い正確に計測 出来る。図-4のガラス/充填剤間の剥離では、5% ほどの電流密度の低下が確認できた。 同様に、図-7のようにバックシートの電流密度分布 への影響も計測出来る。



図-6単セルモジュールの外観



図-7単セルモジュールの MAP 画像(疑似カラー表示)

図-6に示す単セルモジュールの MAP 画像を図-7 に示す。測定光に対して出力電流が発生した位置の電 流密度を表示するので、バックシートに測定光が当た り、モジュール内反射光がセルに到着した場合にも電 流密度としてマッピングする。図-7の場合はバック シートの寄与は8%程度である。このスライス機能を 使い、封止材の変質による電流密度分布の変化や、水 垢による電流密度の低下などを計測することが出来 る。

このように MAP シリーズでは測定したすべての画素 で電流密度が mA/cm²単位で算出されているので、他 のマッピング方法では困難な電流密度の数値比較が 可能となっている。

モジュール状態のセル Rsh について

モジュール状態でセルに印加される電圧は、セルの固 有の特性によってモジュールの端子電圧が分圧され るが、その分圧された電圧を決定する要因として暗電 流カーブがある。



図-8に示す様に cell1、cell2の暗電流カーブ のA部の傾きはセル固有のRshによって支配されてい るため、出力電流一定の場合、セルに加わる電圧 Vcl と Vc2は Rsh と相関がある。MAP シリーズでは、測定 時にモジュール全体の暗電流特性より求めた負荷電 圧を加えているため、セルに加わる電圧は前記の Vc1、 Vc2 の状態となっている。



図-9 セルの電流値

この状態での電流出力は図-9に示すセルの I-V カーブの特性に従っているため、セルの動作電圧が低 いほど、電流出力が高く見える。

そのため、MAP画像には、セルごとのRshに見合った、 出来る。



図-10 Rsh の分布

MAP 画像と、モジュール裏面より引き出し線を取付け、一ルの裏面電極にプロービングすることが必要だが、 各セルの I-V 特性を、ソーラーシュミレータで測定し た結果を示す。第2象限の I-V 特性より Cell 3-1 は Rshが低下していることが確認できるがこれはMAP画 像で明るく表示されているセルと一致している。



MAP 画像



EL 画像 図-11 薄膜モジュールの Rsh

図-11に20年近く経過した薄膜モジュールのMAP

画像と EL 画像を示す。MAP 画像では、高感度で Rsh 明るさがセルにオフセットされた画像を得ることが の低下を明るく示している、EL 画像では同じ位置が 暗く見える。

短絡電流密度分布の測定

10000	181	1122	1000	88.8	612	1-118
10103	12.00	6111	1923	14.3	8.82	100
20.239	22.00	1222	100.00	633	REL.	3.28
6 5 8 8 8	122	8111	10.23	12	823 F	112
82388	12.0	1251	12.23		影けた	138
0.0.000	12.00	1221	1123	663	222	121
10100	100		1.8.63	181	211	1118
6 2 1 8 8	12.23		1353	88	514	111
0.0.000	128	1111	10120	111	611	122
10000	1000	1111	128.81	99.8	2:140	126
10000	1000	1122	1000	18.1	83 P	138
1000	121	ERRE	301-23	PER-	81212	100
10001	1999	1111	1953	ыa	REP	100
14401	185.	6188	63-23		El-R	168
10000	1999	03.64	9388		618	1.1.1
10000	13.84	1997	1339	96	818	1.64
100000	1883	101123	1.1163	6131	2.54	10.0
1000	1992	13.6.5	318.83	121	820F	111
1000	18.80	1000	*130	1.8.4	212	120
1000	13.20	1212	2015	100	222	2.2

図-12 Pmax 近傍の電流密度分布 (CIGS) 図-12に示す様に通常モジュールを測定する際は Pmax 近傍の負荷電圧をモジュールに加えてセルのイ ンピーダンスを下げ、電流密度分布を測定している。 特別に短絡状態での電流密度から Pmax までの広い範 囲での電流密度分布を測定する場合は、図-13に示 図-10に、製造後20年近く経過したモジュールの すインテリジェントホルダを使用できる。薄膜モジュ 各セルをマルチプレクサで順次 ON-OFF して単セルと して扱い、測定系と同期して測定していく方法である。





C部 D部

図-16 にセル内の Rs の分布を示す、C 部、D 部はフィ ンガーが切断されているため Rs が高い。 単位は Ω cm²である。

図-16 Rs マップ

色素増感度セルの測定

色素増感セルは、光によって発生した電荷が電解液中 イオンの移動という形で電極に到達するために、光を 当ててから一定の時間を置いて出力が得られ反応の 遅い電池と言える。そのため電流密度分布を測定する 場合は結晶系、薄膜系のセルを測定する場合と比べて スキャン速度を落とす必要がある。MAP シリーズはこ のスキャン速度を自由に変えられる上、ラインスキャ ンから得られた光電流値をCT計算で二次元の電流 MAP シリーズでは、負荷電圧を変化して測定する場合、密度分布に変換するという能率の良い測定方法を採



図-15 色素増感セルの電流密度測定

図-14インテリジェントホルダ外観 図-14に示す、セルピッチに合わせた、専用測定治 具を追加することにより、短絡状態の電流密度分布を 測定できる。

Rs 分布測定

負荷電圧を高くすると、流れこむ電流が増加するが、 Head アンプ部の容量を増加しておくと、Voc に近い部 分の電流分布密度の測定が可能となる。

すべての画素(測定の単位面積)で I-V 特性を算出し 用しているので、ゆっくりしたスキャン速度でもスピ ているので、図-15のA部、B部に示す I-V カーブ ーデーに測定を進められる。 の傾きより Rs の面内分布を得ることが出来る。



波長選択機能の応用

一般的な測定は1SUNの光強度とエアマス1.5相当の スペクトル下で行われるが、MAP シリーズは光強度、 スペクトルともに選択可能である。



図-16 IR でのマッピング

図-16に赤外照明でのMAP画像を示す。暗い網目部 分ではセルの熱処理に起因する裏面電界効果(BSF E)欠如があると考えられる。又、バスライン下部に クラックが確認できる。このように赤外照明を用いる とセルの裏面の状態を観察出来る。

同様に実際にモジュールが使われている状態に合わ せた曇天時の状態を再現した測定や、波長別感度の異 なる複数の受光層を有するモジュールで、波長と電流 密度分布を比較することも可能である。

まとめ

MAP シリーズを使う太陽電池モジュールの解析には 以下の手法があり、出力電流密度分布の測定の実績を 積んでいる。

 セルおよび構成部材に起因する、電流密度 分布の数値比較。

> 具体的には、クラックや PN ジャンクション の劣化、集電部の不具合による分布の面内 アンバランス、封止材及び構成部材の不具 合による電流密度の低下、バックシートの 発電への寄与。

- 結晶系セルの Rsh 低下セル及び薄膜系の Rsh 低下部位の特定。
- インテリジェントホルダを使用しての直列
 薄膜モジュールの短絡電流密度分布から
 Pmax以上までの電流密度分布までの測定。
- 負荷電圧を Pmax より高くまで測定して、Rsの測定。
- 5. スロースキャン機能を使い時間応答性の 低い色素増感セルの測定。

このように全種類の太陽電池モジュールの電流密 度分布、Rsh、Rs 分布を短時間のうちに計測出来 る MAP シリーズは、EL 測定、熱画像測定と合わせ て、モジュールの評価には 効果的なツールである。